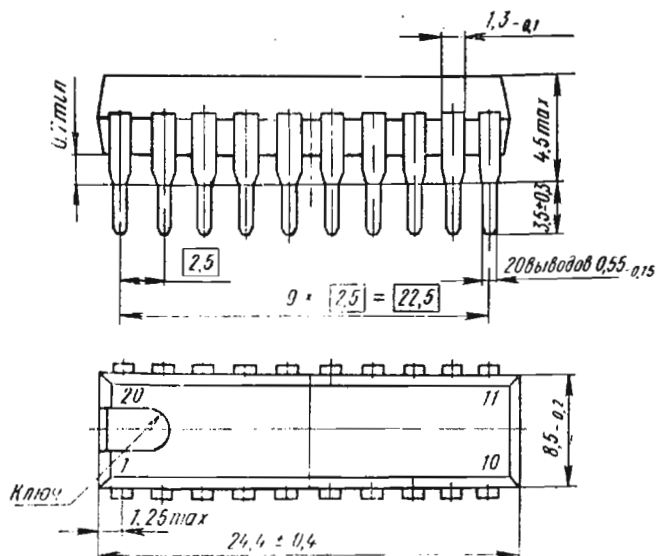


МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ КР559

Общие данные

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ

(корпус 2146.20-1)



Масса не более 1,8 г

Смещение осей выводов от номинального расположения $\pm 0,1$ мм (допуск зависимый). Нумерация выводов показана условно.

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц 1—2000

амплитуда ускорения, м/с^2 (g) 200 (20)

Механический удар одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, м/с^2 (g) 1500 (150)

длительность действия ударного ускорения, мс 0,1—2,0

Механический удар многократного действия:

пиковое ударное ускорение, м/с^2 (g) 1500 (150)

длительность действия ударного ускорения, мс 1—5

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ КР559

Общие данные

Линейное ускорение, м/с ² (g)	5000 (500)
Повышенная рабочая температура среды, °C	70
Повышенная предельная температура среды, °C . .	85
Пониженная рабочая температура среды, °C	минус 10
Изменение температуры среды, °C	от минус 60 до +85

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка*, ч	50 000
Срок сохраняемости*, лет	20

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ГОСТ 18725—83 и требованиями, изложенными ниже.

Допустимое значение статического потенциала 30 В.

Для микросхем, подлежащих автоматизированной сборке, рекомендуется следующий режим:

температура припоя — не выше 265°C;

продолжительность пайки — не более 4 с;

число допускаемых переспаяк выводов микросхем при проведении монтажных (сборочных) операций — не более трех;

используемые средства и химические реактивы — по ГОСТ 20.39.405—84.

Перед монтажом должны быть произведены обрезка и формовка микросхем.

Перед пайкой микросхемы устанавливают на керамические платы, предварительно нагретые до температуры 120°C, после чего потоками нагретых газов осуществляют нагрев микросхем и локальный нагрев мест пайки на керамической плате до расплавления припоя. При этом микросхему нагревают сверху (температура газа равна 220±10°C), а керамическую плату нагревают снизу (температура газа равна 380±20°C). Общий нагрев керамической платы с микросхемами не должен превышать температуры 250°C.

Длительность нахождения одной микросхемы при температуре расплавленного припоя не более 1 мин.

* В скобках даны значения для микросхем, работающих в режиме КМОП.

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ КР559

Общие данные

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение питания, В:

максимальное	
для КР559ИП1, КР559ИП2	5,5
» остальных	5,25
минимальное	
для КР559ИП1, КР559ИП2	4,5
» остальных	4,75

Максимальное напряжение на выходе закрытой
микросхемы, В:

для КР559ИП1	3,5
» КР559ИП6 по выводам 2, 7, 9, 15	3,75
» КР559ИП3 по выводам 1, 4, 12, 15	4
» КР559ИП13, КР559ИП14 по выводам 1—8, 12—19	4

Минимальный выходной (вытекающий) ток, мА:

для КР559ИП1	минус 0,44
» КР559ИП12	минус 20
» КР559ИП13, КР559ИП14 по выводам 1—8	минус 3
» » » по выводам 12—19	минус 10
для КР559ИП2, КР559ВН1, КР559ВТ1, КР559ИП8	минус 1

Максимальный выходной (втекающий) ток, мА:

для КР559ИП1	70
» КР559ИП2	8
» КР559ИП3 по выводам 1, 4, 12, 15	70
» КР559ИП6 по выводам 1, 7, 9, 15	48
» КР559ИП8 по выводам 8, 9, 11, 12	70
» » » 6, 7, 17, 18	20
» » » по выводу 3	8
для КР559СК1	70
» КР559ИП11	8
» КР559ИП12	20
» КР559ИП13 по выводам 1—8	16
» КР559ИП14 по выводам 12—19	48

Дифференциальное напряжение на входах для

КР559ИП11 по выводам 1, 2, 6, 7, 9, 10, 14, 15, В:

максимальное	7
минимальное	минус 7

Напряжение синфазного сигнала для КР559ИП11 на

входах 2, 6, 7, 9, 10, 14, 15, В:

максимальное	7
минимальное	минус 7

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 (при температуре $25 \pm 10^\circ\text{C}$)

Напряжение питания, В	$5 \pm 5\%$
Ток потребления, мА, не более	125
Входной ток низкого уровня, мкА, не менее	минус 150
Входной ток высокого уровня, мкА, не более . . .	15
Выходной ток высокого уровня, мкА, не более . .	5
Выходное напряжение низкого уровня, В, не более	0,75
Время задержки распространения при включении (выключении), нс, не более	25